

晶体振荡器 (扩展频谱)
输出: CMOS

SG - 9001LB / CA / JC 系列

- 频率范围 : 10 MHz ~ 166 MHz
- 电源电压 : 3.3 V Typ.
- 功能 : 使能(OE)
- 外部尺寸规格 : 5.0 × 3.2 × 1.2 mm ...SG-9001LB
7.0 × 5.0 × 1.4 mm ...SG-9001CA
10.5 × 5.8 × 2.7 mm ...SG-9001JC
- 扩展比率范围可编程选择 (中心或下部扩展, 6个值)



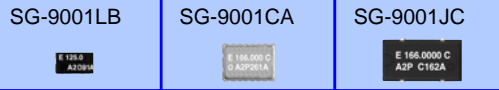
仅 CA, LB 类型

LB, CA, JC 类型

产品号码(请联系我们)
SG-9001LB: Q3331x2x0xxxx00
SG-9001CA: Q3331x0x0xxxx00
SG-9001JC: Q3331x1x2xxxx00



实际尺寸



规格 (特征)

项目	符号	规格说明	条件
输出频率范围	f _o	10.000 MHz ~ 166.000 MHz 10.000 MHz ~ 135.000 MHz	SG-9001JC, CA 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 SG-9001LB
电源电压	V _{cc}	3.3 V ± 0.3 V	
储存温度	T _{stg}	-55 °C ~ +100 °C -40 °C ~ +125 °C	SG-9001JC 裸存 SG-9001LB, CA
工作温度	T _{use}	-20 °C ~ +70 °C	
功耗	I _{cc}	30 mA Max.	无负载条件, f _o = 166 MHz
输出禁用电流	I _{dis}	20 mA Max.	OE=GND, f _o = 166 MHz
占空比	SYM	45 % ~ 55 %	CMOS 负载: 50 % V _{cc} 极, L _{CMOS} =15 pF
输出电压	V _{OH} V _{OL}	V _{cc} -0.4 V Min. 0.4 V Max.	I _{OH} =-8 mA I _{OL} = 8 mA
输出负载条件	L _{CMOS}	15 pF Max.	
输入电压	V _{IH} V _{IL}	70 % V _{cc} Min. 30 % V _{cc} Max.	OE 终端
上升/下降时间	t _r / t _f	2.7 ns Max.	20 % V _{cc} ~ 80 % V _{cc} 极, L _{CMOS} =15 pF.
振荡启动时间	t _{str}	10 ms Max.	在电源电压最低时, 所需时间为 0 秒
频率老化	f _{aging}	±5 × 10 ⁻⁶ / year Max.	+25 °C, 第一年

产品名称 SG-9001LB 125.000000MHz C 05 P

(标准显示)

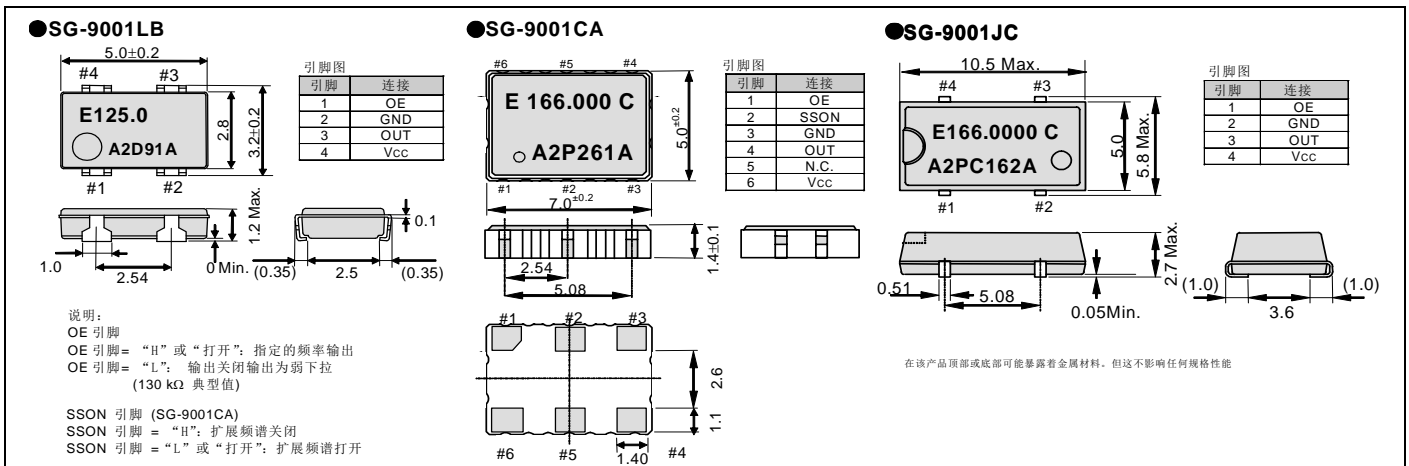
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①型号 ②包装类型 ③频率 ④扩展类型 ⑤百分比(编码) ⑥功能(P: 使能)

C:中心扩展	编码	02	05	07	10	15	20
	百分比	±0.25 %	±0.5 %	±0.75 %	±1.0 %	±1.5 %	±2.0 %
D:下部扩展	编码	05	10	15	20	30	40
	百分比	-0.5 %	-1.0 %	-1.5 %	-2.0 %	-3.0 %	-4.0 %

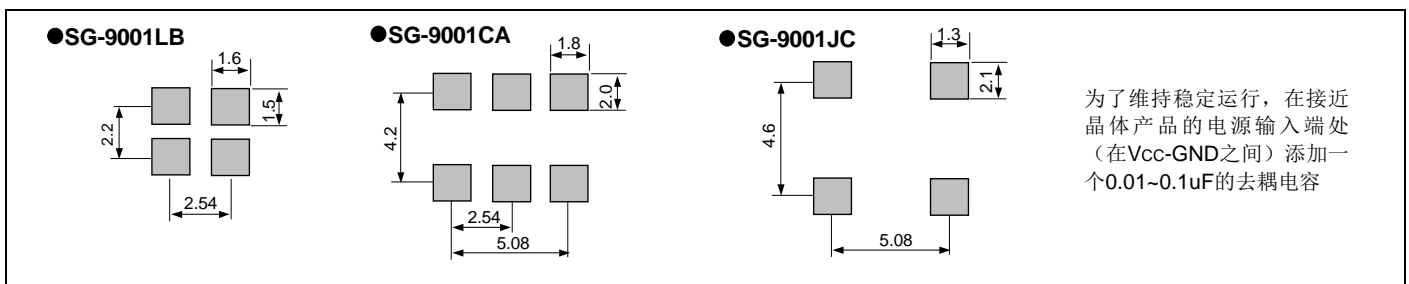
外部尺寸规格

(单位: mm)



推荐焊盘尺寸

(单位: mm)



为了维持稳定运行, 在接近晶体产品的电源输入端处 (在V_{cc}-GND之间) 添加一个0.01~0.1uF的去耦电容